более эффективную. Принимаем систему охлаждения – естественный конвективный теплообмен.

## 4.6.4 Расчет на механические воздействия

Целью расчета является определение действующих на элементы изделия перегрузок при действии вибрации и ударов, а также максимальных перемещений.

## 4.6.4.1 Расчет на действие вибрации

Определим цилиндрическую жесткость платы:

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-v^2)},\tag{4.11}$$

где E - модуль упругости для материала платы:  $3.02 \cdot 10^{10} \ \frac{\text{H}}{\text{M}^2}$ ;

h - толщина ПП: 0,0018 м;

*v* - коэффициент Пуассона: 0,3.

Подставим имеющиеся значения в (4.22), получим:

$$D = \frac{3,02 \cdot 10^{10} \cdot 0,0015^{3}}{12(1-0,3^{2})} = 9,3 \text{ H} \cdot \text{M}$$

Определим частоту собственных вибраций:

$$f_0 = \frac{\pi}{2a^2} \left( 1 + \frac{a^2}{b^2} \right) \sqrt{\frac{D}{M}} ab , \qquad (4.12)$$

где *а* -длина платы: 0,049 м;

*b* - ширина платы: 0,019 м.

M - масса платы с элементами: 0,02 кг.

Подставим имеющиеся значения в (4.23), получим:

$$f_0 = \frac{3.14}{2 \cdot 0.16^2} \left( 1 + \frac{0.16^2}{0.12^2} \right) \sqrt{\frac{9.3}{0.76} \cdot 0.16 \cdot 0.12} = 83 \ \Gamma \text{ц}$$

Определим коэффициент динамичности для динамического возбуждения:

$$\mu = \frac{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \eta^2}}{\sqrt{\left(1 - \eta^2\right)^2 + \varepsilon^2 \eta^2}},\tag{4.13}$$

где  $\varepsilon$  - показатель затухания: 0,01;

$$\eta = \frac{f_{\text{max}}}{f_0} = \frac{35}{83} = 0,42$$
 - коэффициент расстройки;

 $f_{\rm max}$  - максимальная частота по ТЗ.

Подставим имеющиеся значения в (4.24), получим:

$$\mu = \frac{\sqrt{1 + 0.01^2 \cdot 0.42^2}}{\sqrt{\left(1 - 0.42^2\right)^2 + 0.01^2 \cdot 0.42^2}} = 1.1$$

Определим амплитуду вибросмещения основания:

$$\varepsilon_0 = \frac{a_0}{4\pi^2 \cdot f_{\text{max}}^2},\tag{4.14}$$

где  $a_0$  - виброускорение: 29,4  $\frac{\text{M}}{\text{c}^2}$  .

Подставим имеющиеся значения в (4.25), получим:

$$\varepsilon_0 = \frac{29.4}{4 \cdot 3.14^2 \cdot 35^2} = 6 \cdot 10^{-4} \text{ M}.$$

Определим виброускорение и виброперемещение ЭРЭ. Для расчета возьмем лампу 6Н3П.

$$\gamma = \frac{\sqrt{(1 + (Kx \cdot Ky - 1)\eta^2)^2 + \varepsilon^2 \eta^2}}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + \varepsilon^2 \eta^2}},$$
(4.15)

где Кх, Ку - показатели затухания формы колебаний: 1,3;

Подставим имеющиеся значения в (4.26), получим

$$\gamma = \frac{\sqrt{\left(1 + \left(1, 3 \cdot 1, 3 - 1\right) \cdot 0, 42^{2}\right)^{2} + 0, 01^{2} \cdot 0, 42^{2}}}{\sqrt{\left(1 - 0, 42^{2}\right)^{2} + 0, 01^{2} \cdot 0, 42^{2}}} = 1,362.$$

Виброускорение элемента:

$$a_a = a_0 \cdot \gamma = 29, 4 \cdot 1,362 = 40 \frac{M}{c^2}$$
 (4.16)

Виброперемещение элемента:

$$s_a = \varepsilon_0 \cdot \gamma = 6 \cdot 10^{-4} \cdot 1,362 = 8,1 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$
 (4.17)

Опредилим максимальный прогиб ПП:

$$\delta_a = \left| s_a - \varepsilon_0 \right| = \left| 8.1 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-4} \right| = 2.1 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$
 (4.18)

Определим допустимый прогиб платы:

$$s_a = 0, 3h = 0, 3 \cdot 0,0015 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$
 (4.19)

Таким образом, плата и ЭРЭ удовлетворяют условиям ТЗ по виброустойчивости.

#### 4.6.4.2 Расчет на действие удара

Исходные данные: воздействующий импульс полусинусоидальной формы.

Определяем условную частоту ударного импульса:

$$\omega = \frac{1}{\tau} \,, \tag{4.20}$$

где  $\tau$  – длительность ударного импульса, по ТЗ  $\tau$  = 5мс.

Отсюда следует по (4.20), что  $\omega = 200 \ c^{-1}$ 

Определяем коэффициент передачи при ударе:

$$K_{y} = \frac{2\nu}{\nu^2 - 1} \cos\left(\frac{\pi}{2\nu}\right),\tag{4.21}$$

где

$$v = \frac{\omega}{2\pi f_0} = \frac{200}{2 \cdot 3.14 \cdot 83} = 0.4 \tag{4.22}$$

Подставив (4.22) в (4.21) получим:

$$K_y = \frac{2 \cdot 0.4}{0.4^2 - 1} \cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot 0.4}\right) = 0.67$$

Определение ударного ускорения по формуле (4.16):

$$a_a = a_0 \cdot K_y = 29, 4 \cdot 0, 67 = 20 \frac{M}{c^2}$$

Таким образом, спроектированная ПП соответствует требованиям указанным в ТЗ.

#### 4.6.5 Расчет технологичности

Базовые показатели технологичности приведены в табл. 4.6.5.1.

Таблица 4.6.5.1 – базовые показатели технологичности

Наименование показателя	Формула расчета	Значение	Знач имос ть $\varphi_i$	Примечание
Коэффициент использования микросхем	$k_{HMC} = \frac{H_{UMC}}{H_{HMC} + H_{\ni P\ni}}$	0,047	1,0	$H_{\mathit{UMC}} = 1$ — количество ИМС $H_{\mathit{3P3}} = 21$ — общее количество ЭРЭ
Коэффициент механизации и автоматизации монтажа	$k_{AM} = \frac{H_{AM}}{H_{M}}$	0,59	1,0	$H_{AM}=36$ – кол-во соед-й, получ. автом. способом $H_{M}=61$ – общее кол-во монтажных соединений
Коэффициент механизации подготовки к монтажу	$k_{MII} = \frac{H_{MIIH \ni T}}{H_{H \ni T}}$	0	0,8	$H_{M\Pi U \ni T} = 0$ — кол-во мех-но подготовленных ИЭТ $H_{U \ni T} = 21$ общее число ИЭТ
Коэффициент механизации контроля и настройки	$k_{MKH} = \frac{H_{MKH}}{H_{KH}}$	0	0,5	$H_{MKH} = 0$ – кол-во операций мех-го контроля и настройки $H_{KH} = 1$ – общее кол-во операций контроля и настройки
Коэффициент повторяемости ЭРЭ	$k_{\textit{\Piosm} \ni P\ni} = 1 - \frac{H_{\textit{T}\ni P\ni}}{H_{\ni P\ni}}$	0,48	0,3	$H_{TЭРЭ} = 10$ — количество типоразмеров ЭРЭ $H_{3P9} = 21$ — общее количество ЭРЭ
Коэффициент применямости ЭРЭ	$k_{\Pi p \iota M \ni P \ni} = 1 - \frac{H_{Op \ni P \ni}}{H_{T \ni P \ni}}$	0,8	0,2	$H_{Op  ext{-}P ext{-}9} = 0$ – количество оригинальных ЭРЭ $H_{T ext{-}P ext{-}9} = 10$ – количество типоразмеров ЭРЭ

Комплексный показатель технологичности:

$$K_{p} = \frac{\sum_{i=1}^{6} K_{i} \varphi_{i}}{\sum_{i=1}^{7} \varphi_{i}} = \frac{10,47+10,59+00.8+00,5+0,480,3+0,80,2}{1.0+1.0+0.8+0.5+0.3+0.2} = \frac{1,36}{3,8} \approx 0,35$$
(4.23)

К=0,35 – подходит для мелкосерийного производства. Таким образом, конструкция ячейки имеет необходимый уровень технологичности.

## 4.6.6 Расчет надежности

Интенсивность отказа элементов с учетом условий эксплуатации изделия:

$$\lambda_i = \lambda_{0i} \cdot k_1 k_2 k_3 k_4 a_i(T, k_1),$$

где  $\; \lambda_{0i} \;$  - номинальная интенсивность отказов (см. табл. 4.6.2.1)

 $k_1$  и  $k_2$  - поправочные коэффициенты в зависимости от воздействия мех. факторов;

k<sub>3</sub> - поправочный коэффициент в зависимости от воздействия влажности и температуры;

k<sub>4</sub> - поправочный коэффициент в зависимости от давления воздуха;

 $a_i(T,k_{\scriptscriptstyle H})$  - поправочный коэффициент в зависимости от температуры поверхности элемента T и коэффициента нагрузки  $k_{\scriptscriptstyle H}$  (см. табл. 4.6.7.1);

 $k_1$ =1,04,  $k_2$ =1,03 (стационарные условия эксплуатации),

 $k_3=2,0, k_4=1$  (нормальное давление).

В табл. 4.6.7.1 представлены данные о интенсивности отказов всех компонентов.

Таблица 4.6.7.1 Интенсивности отказов компонентов

Компоненты и ЭРЭ	Номинальная интенсивность отказов, $\lambda_{70} \cdot 10^{-6}$ 1/ч	Поправочный коэффициент, $a_i(T,k_{\scriptscriptstyle H})$	Интенсивность отказов, $\lambda_i \cdot 10^{-6}  1/\mathrm{ Y}$	Количество
Схемы интегральные	0,2	0,7	0,03	1
Резисторы	0,01	0,5	0,011	11
Диоды	0,15	0,2	0,064	7
Соединения контактные	0,05	0,3	0,032	8
Пайка ручным способом	0,2	-	0,43	25
Пайка в печи	0,15	-	0,32	36

Рассчитаем суммарную интенсивность отказов и построим график зависимости вероятности отказов от времени (рис. 4.6.7.1):

$$\Lambda = (0.03 + 0.011 \times 11 + 0.064 \times 7 + 0.032 \times 8 + 0.43 \times 25 + 0.32 \times 36) \times 10^{6} = 23 \times 10^{6}$$

Тогда вероятность безотказной работы в течение 1000 ч будет равна:

$$P(t) = \exp(-\Lambda t) = \exp(-23*10^{-6}*1000) = 0,977.$$

Исходя из полученных данных, вероятность безотказной работы в течение 1000ч удовлетворяет условиям, заданным в техническом задании (0.977 > 0.95).

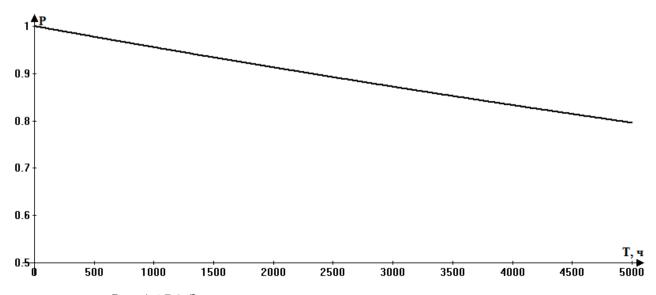


Рис. 4.6.7.1. Зависимость вероятности отказов от времени эксплуатации

# Заключение

В ходе проделанной работы были разработаны функциональная и принципиальные схемы измерителя уровня топлива, конструкция блока, проведено распределение элементов электрической схемы, решены задачи размещения ЭРЭ и трассировки печатного рисунка, проведены необходимые конструкторские расчеты. Разработанное устройство полностью удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям технического задания.

## Список использованных источников

- 1. Конструкторско-технологические проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов / К.И. Билибин, А.И, Власов, Л.В. Журавлева и др. Под общ. ред. В.А. Шахнова М.: Изд-во МГТУ ми. Н.Э. Баумана, 2002. 528 с.
- 2. Сборка и монтаж интегральных микросхем: Учеб. пособие / Романова М.П М.:УлГТУ, 2008.-95 с.
- 3. Проектирование и технология печатных плат: Учебник / Пирогова Е. В. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 560 с.
- 4. Методические указания к курсовой работе «Компоновка и расчет конструктивных параметров блоков ЭВА» / А.Н. Чеканов, В.В. Съедугин, В.В. Маркелов М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1980, 45с
- 5. Теоретические основы конструирования и надежности ЭВС. Курс лекций М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011, (рукопись)
- 6. Технология ЭВС. Курс лекций М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011, (рукопись)
- 7. Конструирование ЭВС. Курс лекций М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012, (рукопись)